

05; 09

© 1991 г.

СПИН-ВОЛНОВЫЕ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЕОДНОРОДНЫХ ПО ТОЛЩИНЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ

Л. В. Луцев

Получено рекуррентное соотношение, описывающее дисперсионные характеристики магнитостатических волн (МСВ), распространяющихся в многослойных ферромагнитных пленках. Показано, что с каждой границей можно связать алгебраическую конструкцию, имеющую структуру грасмановой алгебры. Исследуются симметрии локального и глобального типов, оставляющие инвариантным вид дисперсионной зависимости. Рассматриваются обобщения рекуррентного дисперсионного соотношения МСВ на случаи ферромагнитных сверхрешеток и пленок с непрерывным изменением магнитных параметров по толщине. Построены зависимости групповых скоростей МСВ, полученных численным дифференцированием дисперсионных кривых, для случая пленок с линейным изменением намагниченности по толщине. Теоретические зависимости сравниваются с экспериментальными значениями групповых скоростей прямой объемной МСВ, полученными на пленке $Y_3Fe_5O_{12}$: Ga, La.

Введение

Изучение длинноволновых спиновых возбуждений — магнитостатических волн (МСВ) в ферромагнитных пленках представляет теоретический интерес и является важным для прикладных применений. Переход от однородных ферромагнитных пленок к многослойным структурам, к пленкам с непрерывным изменением намагниченности по толщине, к ферромагнитным сверхрешеткам дает возможность получения дисперсионных характеристик МСВ с заданной функциональной зависимостью. Исследования дисперсии МСВ в многослойных пленках и в пленках с непрерывным изменением намагниченности по толщине проводились в [1-8].

Преимуществом описанного ниже способа получения дисперсионных соотношений по сравнению со способами, описанными в [1-8], является возможность перехода от многослойной, дискретной структуры к пленочной структуре с изменяющимися значениями магнитных параметров по толщине. При выводе сохранялся член $\text{Re } \mu_{xx}$, который появляется при наклонном подмагничивании пленки и в случае существования в пленке кубической, гексагональной и т. п. анизотропий. В силу этого полученные дисперсионные зависимости имеют более общий вид, чем в [1-8], где член $\text{Re } \mu_{xx}$ опускался.

В качестве примера найдены производные дисперсионных соотношений — групповые скорости прямой объемной МСВ в пленке с линейным профилем намагниченности по толщине. Теоретические значения сравниваются с экспериментальными.

1. Вывод дисперсионных соотношений

Рассмотрим ферромагнитную пленку, состоящую из $N=n$ слоев. Направление магнитного поля \mathbf{H} произвольно. Ось Oz направим перпендикулярно поверхности пленки, ось Ox — вдоль волнового вектора МСВ \mathbf{k} . Допустим, что пленка имеет толщину d_n и занимает интервал на оси Oz $[0, -d_n]$. Свойства МСВ определяются уравнением Уокера [9]

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \mu_{ik}^{(j, \epsilon)} \frac{\partial}{\partial x_k} \varphi^{(j, \epsilon)} = 0 \quad (x_{i,k} = x, y, z), \quad (1)$$

где $\varphi^{(j, \epsilon)}$ — магнитостатический потенциал МСВ в j -слое или вне пленки (в этом случае $\mu_{ik}^{(\epsilon)} = \delta_{ik}$); $\mu_{ik}^{(j)} = \mu_{ik}^{(j)*}$ — тензор магнитной проницаемости j -слоя, обладающий свойством эрмитовости.

Благодаря выбору системы координат производные по y в (1) равны нулю. Решение (1) будем искать в виде

$$\varphi^{(j, \epsilon)} = \exp(ikx) [A_C^{(j, \epsilon)} \exp(i\beta_C^{(j, \epsilon)} kz) + A_D^{(j, \epsilon)} \exp(i\beta_D^{(j, \epsilon)} kz)]. \quad (2)$$

После подстановки в (1) находим значения $\beta_{C(D)}^{(j)}$ j -слоя

$$\beta_{C(D)}^{(j)} = \mu_{zz}^{(j)-1} \{ -\text{Re} \mu_{zz}^{(j)} \pm [(\text{Re} \mu_{zz}^{(j)})^2 - (\mu_{zz}^{(j)} \mu_{xx}^{(j)})^{1/2}] \}, \quad (3)$$

где индексу C соответствует знак «+», индексу D — знак «-».

Для решения вне пленки

$$\begin{aligned} A_D^{(\epsilon)} &= 0, \quad \beta_C^{(\epsilon)} = i \quad (z > 0), \\ A_C^{(\epsilon)} &= 0, \quad \beta_D^{(\epsilon)} = -i \quad (z < -d_n). \end{aligned} \quad (4)$$

Граничные условия уравнения Уокера заключаются в непрерывности $\varphi^{(j, \epsilon)}$ и z -составляющей индукции $\mu_{zi}^{(j, \epsilon)} \partial \varphi^{(j, \epsilon)} / \partial x_i$ на границах слоев. Подстановка (2) в граничные условия дает систему линейных уравнений относительно $A_{C(D)}^{(j, \epsilon)}$. Равенство нулю детерминанта этой системы определяет дисперсионные соотношения МСВ. Любой детерминант можно представить в виде косога произведения 1-форм [10]. С выделением этих 1-форм естественно возникает структура внешней или грассмановой алгебры [11].

Для представления детерминанта через косо произведение форм определим 1-формы типа C и D , связанные с границей $S_j (-d_j)$, находящейся между слоями j и $j+1$,

$$\begin{aligned} \omega_{C(D)}^{(j)} &= \begin{pmatrix} \omega_{C(D)1}^{(j)} \\ \omega_{C(D)2}^{(j)} \end{pmatrix} = \exp[-i\beta_{C(D)}^{(j)} kd_j] \begin{pmatrix} 1 \\ k(\beta_{C(D)}^{(j)} \mu_{zz}^{(j)} + \mu_{zz}^{(j)}) \end{pmatrix}, \\ \bar{\omega}_{C(D)}^{(j)} &= \begin{pmatrix} \bar{\omega}_{C(D)1}^{(j)} \\ \bar{\omega}_{C(D)2}^{(j)} \end{pmatrix} = -\exp[-i\beta_{C(D)}^{(j+1)} kd_j] \begin{pmatrix} 1 \\ k(\beta_{C(D)}^{(j+1)} \mu_{zz}^{(j+1)} + \mu_{zz}^{(j+1)}) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5)$$

В дальнейшем понадобятся формы $\omega_F^{(0)}$, $\bar{\omega}_E^{(n)}$, определенные на границах S_0 и S_n и связанные с внешним окружением пленки. Они получаются соответственно из форм $\omega_C^{(j)}$ и $\bar{\omega}_D^{(j)}$ при $\beta_C = i$, $\beta_D = -i$, $\mu_{zz} = 1$, $\mu_{zz} = 0$. Из $\omega_C^{(j)}$, $\omega_D^{(j)}$, $\bar{\omega}_C^{(j)}$, $\bar{\omega}_D^{(j)}$ ($\omega_F^{(0)}$, $\bar{\omega}_E^{(n)}$) можно выделить две образующие грассмановой алгебры, определенной на границе S_j .

Детерминант системы уравнений, получившейся после подстановки (2) в граничные условия, в терминах форм (5) имеет вид:

$$w^{(n)} = \begin{vmatrix} & & & & 0 \\ & & & & \vdots \\ & & U_{n-2}^{n-1} & & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 \dots 0 & \omega_{C1}^{(n)} & \omega_{D1}^{(n)} & \bar{\omega}_{E1}^{(n)} & \\ 0 \dots 0 & \omega_{C2}^{(n)} & \omega_{D2}^{(n)} & \bar{\omega}_{E2}^{(n)} & \end{vmatrix} = G_{DE}^{(n)} M_D^{(n)} - G_{CE}^{(n)} M_C^{(n)}, \quad (6)$$

где $G^{(j)} = *(\omega^{(j)} \wedge \bar{\omega}^{(j)}) = \omega_1^{(j)} \bar{\omega}_2^{(j)} - \omega_2^{(j)} \bar{\omega}_1^{(j)}$; \wedge — внешнее произведение; $*$ — оператор Ходжа, переводящий 2-форму в 0-форму (скаляр) [10]; формы $\omega^{(j)}$, $\bar{\omega}^{(j)}$ — формы типа C , D , E или F ; $M_D^{(n)}$, $M_C^{(n)}$ — миноры матрицы U_{n-2}^{n-1} , получающиеся вычеркиванием соответственно последнего или предпоследнего столбца.

Нижние индексы $G^{(j)}$ определяются типом форм $\omega^{(j)}$ и $\bar{\omega}^{(j)}$. Вид матрицы U_{n-2}^{n-1} для вывода рекуррентного дисперсионного соотношения несуществен.

Целесообразность выделения структуры грассмановых алгебр, связанных с границами S_j и состоящих из 1-форм (5), 2-форм $\omega^{(j)} \wedge \bar{\omega}^{(j)}$ и 0-форм $G^{(j)}$, заключается в том, что дисперсионные соотношения выражаются только через формы этих алгебр.

Добавим еще один слой к n -слойной пленке ($N=n+1$). Детерминант линейной системы станет равным

$$\begin{aligned} w^{(n+1)} &= \begin{vmatrix} & & & 0 & 0 & 0 \\ & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \omega_{C1}^{(n)} & \omega_{D1}^{(n)} & \bar{\omega}_{C1}^{(n)} & \bar{\omega}_{D1}^{(n)} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \omega_{C2}^{(n)} & \omega_{D2}^{(n)} & \bar{\omega}_{C2}^{(n)} & \bar{\omega}_{D2}^{(n)} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \omega_{C1}^{(n+1)} & \omega_{D1}^{(n+1)} & \bar{\omega}_{E1}^{(n+1)} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \omega_{C2}^{(n+1)} & \omega_{D2}^{(n+1)} & \bar{\omega}_{E2}^{(n+1)} \end{vmatrix} = \\ &= M_D^{(n)} (G_{DE}^{(n+1)} G_{DC}^{(n)} - G_{CE}^{(n+1)} G_{DD}^{(n)}) - M_C^{(n)} (G_{DE}^{(n+1)} G_{CC}^{(n)} - G_{CE}^{(n+1)} G_{CD}^{(n)}). \end{aligned} \quad (7)$$

Введем переменную $\bar{w}^{(n)} = w^{(n)} / M_C^{(n)}$. Учитывая, что $M_C^{(n+1)} = M_D^{(n)} G_{DD}^{(n)} - M_C^{(n)} G_{CD}^{(n)}$, и исключая $M_D^{(n)} / M_C^{(n)}$, из (6), (7) получим рекуррентное соотношение

$$\bar{w}^{(n+1)} = \frac{P_n^{n+1} \bar{w}^{(n)} + R_n^{n+1}}{Q_n^{n+1} \bar{w}^{(n)} + T_n^{n+1}}, \quad (8)$$

где

$$\begin{aligned} P_n^{n+1} &= G_{DE}^{(n+1)} G_{DC}^{(n)} - G_{CE}^{(n+1)} G_{DD}^{(n)}, \\ Q_n^{n+1} &= G_{DD}^{(n)}, \\ R_n^{n+1} &= G_{DE}^{(n+1)} (G_{CE}^{(n)} G_{DC}^{(n)} - G_{CC}^{(n)} G_{DE}^{(n)}) - G_{CE}^{(n+1)} (G_{CE}^{(n)} G_{DD}^{(n)} - G_{CD}^{(n)} G_{DE}^{(n)}), \\ T_n^{n+1} &= G_{CE}^{(n)} G_{DD}^{(n)} - G_{CD}^{(n)} G_{DE}^{(n)}. \end{aligned}$$

Для первого слоя ($n=1$)

$$\bar{w}^{(1)} = \frac{G_{DE}^{(1)} G_{DC}^{(0)}}{G_{DD}^{(0)}} - G_{CE}^{(1)}. \quad (9)$$

Из (8) следует, что коэффициенты перехода $P_l^n, R_l^n, Q_l^n, T_l^n$ от слоя l к слою n образуют матрицу

$$B_l^n = \begin{pmatrix} P_l^n & R_l^n \\ Q_l^n & T_l^n \end{pmatrix}$$

и могут быть найдены через произведение матриц

$$B_l^n = B_m^n B_l^m. \quad (10)$$

Дисперсионные соотношения МСВ для пленки, состоящей из N слоев, получаются при $\bar{w}^{(N)}(f, k, \mathbf{H}, \dots) = 0$, где f — частота переменного магнитного поля.

Принимая во внимание (5) и переходя к переменной $u^{(n)} = \bar{w}^{(n)} \exp(kd_n + i\beta_C^{(n)} kd_n) / k(\beta_C^{(n)} - \beta_D^{(n)}) \mu_{zx}^{(n)}$, запишем коэффициенты рекуррентного соотношения (8) в более удобном виде

$$\begin{aligned} P_n^{n+1} &= \eta_D^{(n+1)} \eta_C^{(n+1)} (\eta_D^{(n)} - \gamma^{(n)} \eta_D^{(n)} - 2i) \frac{q^{(n+1)} - 1}{2i} + \eta_D^{(n)} \gamma^{(n)} (\eta_D^{(n+1)} q^{(n+1)} - \eta_C^{(n+1)}), \\ R_n^{n+1} &= -\eta_C^{(n+1)} \eta_D^{(n+1)} (q^{(n+1)} - 1), \\ Q_n^{n+1} &= (\eta_C^{(n+1)} - \eta_D^{(n+1)}) \left(\eta_D^{(n)} \gamma^{(n)} - \eta_D^{(n+1)} + \eta_D^{(n)} \eta_D^{(n+1)} \frac{1 - \gamma^{(n)}}{2i} \right), \\ T_n^{n+1} &= -\eta_D^{(n+1)} (\eta_C^{(n+1)} - \eta_D^{(n+1)}), \end{aligned} \quad (11)$$

где

$$\begin{aligned}\eta_{\epsilon^{(j)}}^{(j)} &= i + \beta_{\epsilon^{(j)}}^{(j)} \mu_{zz}^{(j)} + \mu_{xz}^{(j)}, \\ q^{(j)} &= \exp [i (\beta_{\epsilon^{(j)}}^{(j)} - \beta_{\mu^{(j)}}^{(j)}) kh_j], \\ \gamma^{(j)} &= \exp (2k\delta^{(j)}),\end{aligned}$$

$h_j = d_j - d_{j-1}$ — толщина j -слоя ($j = 1, \dots, n + 1$).

При переходе от (8) к (11) сделано небольшое обобщение на случай, если между слоями n и $n + 1$ существует зазор шириной $\delta^{(n)}$. Для однородной пленки (первого слоя)

$$u^{(1)} = \frac{1}{\eta_{\epsilon^{(1)}}^{(1)} - \eta_{\mu^{(1)}}^{(1)}} \left[q^{(1)} \frac{\eta_{\epsilon^{(1)}}^{(1)} (\eta_{\epsilon^{(1)}}^{(1)} - 2i)}{\eta_{\mu^{(1)}}^{(1)} - 2i} - \eta_{\epsilon^{(1)}}^{(1)} \right]. \quad (12)$$

2. Симметрии дисперсионных соотношений

Свойства симметрии дисперсионных соотношений связаны с видом коэффициентов P, R, Q, T (11). Пространственные переменные входят в $q^{(j)}$ в виде kh_j . Из этого факта вытекает свойство масштабной инвариантности (скейлинга): дисперсионные соотношения, записанные в переменных kh_j , будут одинаковыми для целого класса пленок с одинаковыми отношениями толщин h_i/h_1 ($i = 2, \dots, N$). Группа преобразований $W_L^{(1)}: k \rightarrow a^{-1}k, h_j \rightarrow ah_j$ ($j = 1, \dots, N$) образует однопараметрическую группу Ли.

Можно выделить группу симметрии, связанную с сохранением тензора магнитной проницаемости $\mu^{(j)}$. В общем случае он является функцией частоты f , внешнего магнитного поля \mathbf{H} , намагниченностей $4\pi M^{(j)}$, одноосных, кубических, гексагональных и т. п. полей анизотропий. Но в (11) все эти величины входят в сочетаниях, выражающихся через 4 компоненты тензора магнитной проницаемости j -слоя $\mu_{xx}^{(j)}, \mu_{zz}^{(j)}, \text{Re} \mu_{xz}^{(j)}, \text{Im} \mu_{xz}^{(j)}$. Поэтому дисперсионные соотношения МСВ N -слойной пленки, записанные в переменных $\mu^{(j)}$ (f, \mathbf{H}, \dots) и в скейлинговых переменных kh_j , в общем случае имеют $5N - 2$ параметра. Группу преобразований $W_M^{(\text{обм})}$, сохраняющую значения этих параметров, можно использовать для нахождения дисперсионных зависимостей МСВ в пленках по уже известным зависимостям. Например, из вида тензора магнитной проницаемости $\mu^{(j)}$ [9] j -слоя, имеющего одноосную анизотропию $\mathbf{H}_A^{(j)}$ с осью, перпендикулярной поверхности слоя, следует инвариантность дисперсионных зависимостей МСВ для класса пленок с одинаковыми отношениями $g^{(j)}H/f, g^{(j)}4\pi M^{(j)}/f, g^{(j)}H_A^{(j)}/f, g^{(j)}$, где $g^{(j)}, 4\pi M^{(j)}$ — гиромангнитное отношение и намагниченность j -слоя. Группа преобразований, являющаяся подгруппой $W_M^{(\text{обм})}$, $W_M^{(1)}: f \rightarrow bf, H \rightarrow bH, 4\pi M^{(j)} \rightarrow b4\pi M^{(j)}, H_A^{(j)} \rightarrow bH_A^{(j)}, g^{(j)} = \text{const}$ образует глобальную однопараметрическую группу Ли. Дисперсионные соотношения МСВ пленок с одинаковыми отношениями магнитных величин к частоте получаются из дисперсионных соотношений МСВ конкретной пленки изменением параметра b .

Для случая перпендикулярно намагниченной пленки вид тензора $\mu^{(j)}$ позволяет выделить локальную (калибровочную) группу Ли $W_M^{(z)}: f = \text{const}, g(z) \times (H(z) + H_A(z)) = \text{const}, g(z)4\pi M(z) = \text{const}$. Эта группа нарушается при переходе к касательно намагниченной пленке. По-видимому, группа $W_M^{(z)}$ имеет только теоретический интерес.

3. Дисперсионные соотношения МСВ в ферромагнитных сверхрешетках

Рассмотрим пленку, состоящую из N одинаковых слоев, разделенных зазорами шириной δ . Коэффициенты $P_1^N, R_1^N, Q_1^N, T_1^N$ легко получить из матричного соотношения (10)

$$B_1^N = \prod_{j=1}^{N-1} B_j^{j+1} = L \begin{pmatrix} \lambda_1^{N-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{N-1} \end{pmatrix} L^{-1}, \quad (13)$$

где L — матрица, диагонализующая

$$B_j^{j+1} = B_0 = \begin{pmatrix} P_0 & R_0 \\ Q_0 & T_0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{1,2} = 1/2 \{P_0 + T_0 \pm [(P_0 - T_0)^2 + 4Q_0R_0]^{1/2}\} \quad (14)$$

— собственные значения B_0 .

Дисперсионные зависимости получаются при

$$u^{(N)} = \frac{P_1^N u^{(1)} + R_1^N}{Q_1^N u^{(1)} + T_1^N} = 0. \quad (15)$$

Подставляя (13) в (15), учитывая (14) и то, что знаменатель в выражении (15) является конечной величиной, получаем

$$\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^{N-1} = \frac{(\lambda_1 - P_0)u^{(1)} - R_0}{(\lambda_2 - P_0)u^{(1)} - R_0}. \quad (16)$$

Это дисперсионное соотношение МСВ, распространяющихся в сверхрешетках, в точности соответствует соотношению, полученному в [1] для случаев поверхностной и прямой объемной волн. При $N \rightarrow \infty$ дисперсионные кривые преобразуются в зоны.

4. Дисперсионные соотношения МСВ в пленках с непрерывным изменением магнитных параметров по толщине

Аппроксимируем пленку с изменением тензора $\mu(z)$ по толщине пленкой с N слоями. При $N \rightarrow \infty$ геометрическая конструкция, введенная в разделе 1 для нахождения рекуррентных зависимостей, преобразуется в расслоенное пространство, где базой служит линейное пространство положений бесконечно тонкого слоя на оси Oz , а слоями — введенные выше грасмановы алгебры, которые в разделе 1 были связаны только с границами S_j . Формы (5) преобразуются во внешние дифференциальные формы.

Если частота f внешнего переменного магнитного поля отличается от частот ФМР N слоев пленки, то уравнение Уокера не имеет сингулярного характера и можно применить (8)—(12) для нахождения дисперсионных соотношений МСВ, распространяющихся в этих пленках. Рассмотрим два соседних слоя толщиной dz . Учитывая, что при $dz \rightarrow 0$ $G_{DD} = G_{CC} = 0$, и используя (8) в переменных $u^{(n)}$, $u^{(n+1)}$ и значения коэффициентов P , R , Q , T (11), находим прирост du , выраженный через значения u в точке z . В терминах du/dz полученное соотношение будет иметь вид уравнения Риккати

$$\frac{du}{dz} = J_1 u^2 + J_2 u + J_3,$$

где

$$J_1 = -\frac{\eta'_D}{\eta_D}, \quad J_2 = -ik(\beta_C - \beta_D) - \frac{\eta'_D}{\eta_D}, \quad J_3 = -\frac{ik\eta_C}{\mu_{zz}}, \quad (17)$$

$\eta_{C(D)}$, $\beta_{C(D)}$ определяются соответственно (11) и (3) с заменой дискретного индекса j на непрерывный z .

Значение u на границе $z=0$ находится из (12)

$$u(0) = \frac{2i}{\eta_D - 2i} \Big|_{z=0}. \quad (18)$$

Дисперсионные соотношения МСВ получаются при равенстве нулю решения уравнения Риккати (с начальным условием (18)) на второй границе пленки $z=-d$

$$u(-d; f, \mathbf{H}, k, \dots) = 0. \quad (19)$$

При малых изменениях магнитных параметров по толщине пленки член $J_1 u^2$ в (17) мал по сравнению с членами $J_2 u$ и J_3 . Поэтому возможна аппроксимация решения уравнения (17) последовательными приближениями

$$u_i(z) = u(0) \exp \left[\int_0^z J_2(\xi) d\xi \right] + \int_0^z [J_3(\xi) + J_1(\xi) u_{i-1}^2(\xi)] \exp \left[\int_{\xi}^z J_2(\zeta) d\zeta \right] d\xi, \\ u_0(z) = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots \quad (20)$$

Проанализируем соотношение (20) в первом приближении для случая перпендикулярно намагниченной пленки при отсутствии анизотропии. При

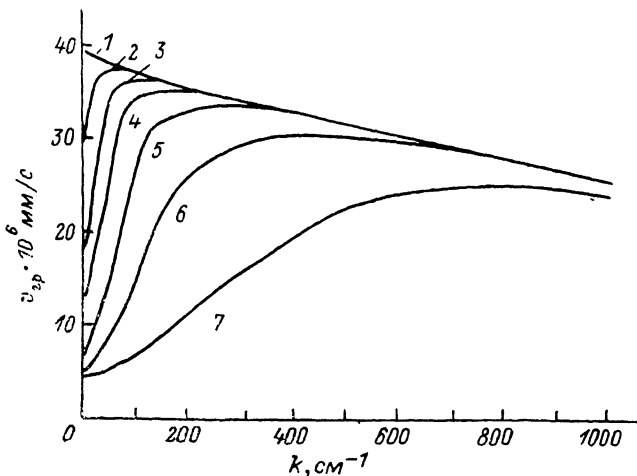


Рис. 1. Зависимости групповой скорости прямой объемной МСВ от волнового вектора для разных значений градиента намагниченности $|\chi|$.

1 — 0, 2 — 1, 3 — 3, 4 — 5, 5 — 10, 6 — 20, 7 — 50 Э/мм; $H = 4930.2$ Э.

стремлении частоты f со стороны больших значений к частотам ФМР слоев пленки главный вклад в интегралы (20) будет вносить окрестность полюса μ_{xx} слоя z_0 с наименьшей намагниченностью $4\pi M_0$. Подынтегральные выражения будут иметь особенность типа $[f - f_0^{\text{ФМР}} + g_0/2 \cdot \partial^2 4\pi M/dz^2|_{z_0} \cdot (z - z_0)^2]^{-1/2}$. При приближении f к $f_0^{\text{ФМР}}$ относительный вклад в интегралы (20) будет определяться все меньшей окрестностью слоя с координатой z_0 , что эквивалентно уменьшению эффективной, влияющей на дисперсию толщины пленки. Поэтому при $f \rightarrow f_0^{\text{ФМР}}$ следует ожидать уменьшения наклона дисперсионной кривой и групповой скорости МСВ. Для проверки этого положения были проведены экспериментальные исследования и численные расчеты по формуле (20).

На рис. 1 и 2 представлены зависимости групповых скоростей $v_{\text{гр}} = 2\pi \partial f / \partial k$ прямой объемной ($\mathbf{H} \parallel Oz$) и поверхностной ($\mathbf{H} \parallel Oy$) МСВ, распространяющихся в пленках с линейным профилем намагниченности по толщине $4\pi M(z) = 4\pi M(0) + \chi z$ ($z \in [0, -h]$). Толщина пленки h равна 5 мкм, одноосная и другие виды анизотропий не учитывались. Намагниченность $4\pi M(0) = 1750$ Э являлась минимальной намагниченностью в случае прямой объемной МСВ ($\chi < 0$) и максимальной намагниченностью для случая поверхностной МСВ ($\chi > 0$). Величина постоянного магнитного поля H выбиралась такой, чтобы частота ФМР слоя с $4\pi M(0)$ равнялась 9 ГГц. Групповые скорости находились путем численного дифференцирования дисперсионной зависимости из (19), (20) в первом приближении. Расчеты проводились на ЕС-1035. Подтверждаются уменьшение $v_{\text{гр}}$ при малых k , которое можно объяснить влиянием полюса μ_{xx} , и появление максимумов на приведенных зависимостях. Для случая поверхностной волны величина групповой скорости различна для противоположных направлений распространения волны и эта разность увеличивается с ростом χ .

На рис. 3 приведены экспериментальные значения и теоретическая зависимость $v_{гр}$ прямой объемной волны, распространяющейся в пленке $Y_3Fe_5O_{12}$: Ga, La с $\min 4\pi M(0)=1594$ Э, $|x|=10$ Э/мкм, $h=13.4$ мкм. Частота f в на-

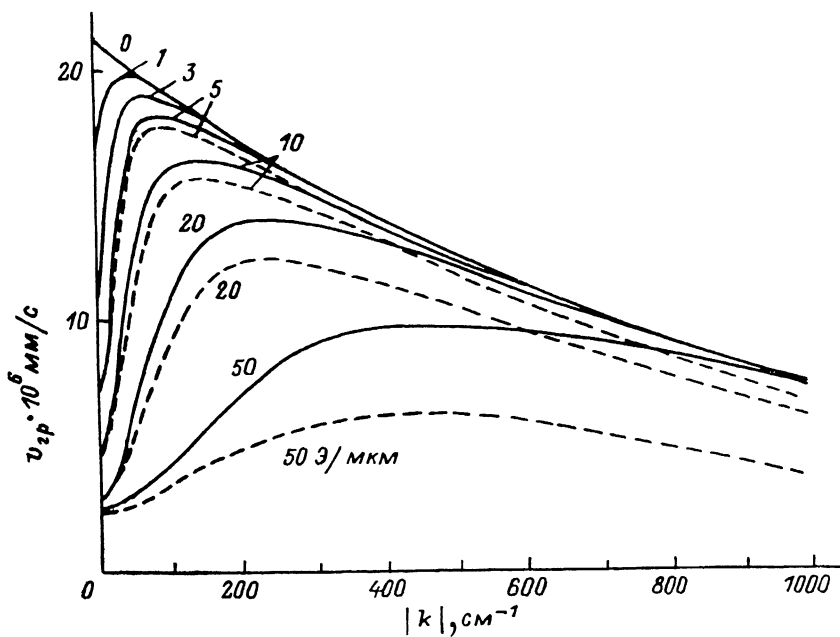


Рис. 2. Зависимости групповой скорости поверхностной МСВ от волнового вектора для разных значений градиента намагниченности k при $H=2423.4$ Э для двух противоположных направлений распространения волны.

$k < 0$ — сплошная линия, $k > 0$ — штриховая линия.

чае зависимости равна 4.520 ГГц ($H=3174$ Э). Эксперимент проводился на линии задержки с расстоянием между приемной и передающей антеннами 5 мм. Толщина антенн 20 мкм. Из рис. 3 видно подтверждение особенности

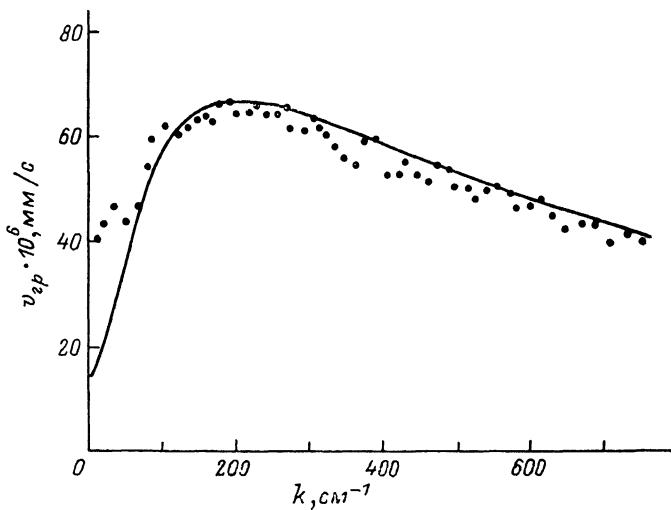


Рис. 3. Экспериментальные значения и теоретическая зависимость групповой скорости прямой объемной МСВ.

неоднородных по толщине пленок (в данном случае пленок с линейным изменением намагниченности по толщине) — уменьшение $v_{гр}$ при $k \rightarrow 0$ и наличие максимума $v_{гр}$ при $k \neq 0$.

В заключение автор благодарит И. Л. Березина за предоставленные образцы пленок и Ю. М. Яковлева за обсуждение работы.

Список литературы

- [1] *Emtage P. R., Daniel M. R.* // Phys. Rev. B. 1984. Vol. 29. N 1. P. 212—220.
- [2] *Grünberg P., Mika K.* // Phys. Rev. B. 1983. Vol. 27. N 5. P. 2955—2963.
- [3] *Филиппов В. В.* // РпЭ. 1988. Т. 33. № 6. С. 1225—1232.
- [4] *Беспятых Ю. И., Зубков В. И.* // ЖТФ. 1975. Т. 45. Вып. 11. С. 2386—2394.
- [5] *Беспятых Ю. И., Вашковский А. В., Зубков В. И., Пфайффер Х.* // ФТТ. 1977. Т. 19. Вып. 6. С. 1743—1747.
- [6] *Buris N. E., Stancil D. D.* // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 1985. Vol. MTT-33. N 6. P. 484—491.
- [7] *Buris N. E., Stancil D. D.* // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 1985. Vol. MTT-33. N 10. P. 1089—1096.
- [8] *Buris N. E., Stancil D. D.* // IEEE Trans. on Magn. 1986. Vol. MAG-21. N 5. P. 859—861.
- [9] *Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский С. В.* Спиновые волны. М., 1967. 368 с.
- [10] *Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т.* Современная геометрия. Методы и приложения. М., 1986. 760 с.
- [11] *Калужнин Л. А.* Введение в общую алгебру. М., 1973. 448 с.

Поступило в Редакцию
19 декабря 1989 г.